

半導体製造プロセスにおいて、材料表面の清浄化および改質は、デバイスの信頼性を確保する上で極めて重要な工程である。集積回路の微細化がサブ10 nmノードへ進行する一方で、一部の領域では新材料の導入と集積回路の三次元化積層化が進む。洗浄・ウェットプロセスにおいては、微細パターンのダメージレス処理と高品質化を両立しなければならない従来の難題に加え、新材料や3次元化に対応した新しい洗浄・ウェットプロセスの研究開発も急がれている。本シンポジウムでは、こういった多様化する半導体デバイスのニーズに合わせた新規なウェットプロセスに関する新しい研究結果について報告する場を提供する。

招待講演

9/19(木)
13:30~
B11会場

- **SiとGe表面のウェットエッチングの新潮流：不動態化から加工まで**
有馬 健太(大阪大学)
- **III-V族化合物半導体のウェットエッチング～窒化物半導体に関する最近の話題を中心に～**
佐藤 威友(北海道大学)
- **多様化する電子デバイスの物理洗浄～スプレー洗浄の有用性とその課題～**
清家 善之(愛知工業大学)
- **DRAMにおける洗浄技術の開発課題**
八木 秀明(マイクロメモリジャパン)
- **次世代三次元フラッシュメモリにおけるウェットプロセスの有用性**
吉水 康人(東芝メモリ)

本シンポジウムに関するお問い合わせ先
オルガノ株式会社 矢野大作(世話人)
yano-d@organo.co.jp